

а 2022 0012

Изобретение относится к технологии производства наноструктурированных материалов, в частности к способам получения магнитных наноструктур.

Способ, согласно изобретению, заключается в производстве путем электрохимической обработки неорганической наноматрицы и электрохимическом осаждении в эту матрицу магнитных металлов. Новизна изобретения состоит в том, что неорганическая наноматрица производится путем анодирования в водном растворе HNO_3 пластины GaAs с кристаллографической ориентацией (100) или (111)В, а осаждение магнитного металла осуществляется в гальваностатическом режиме.

П. формулы: 1

Фиг.: 4